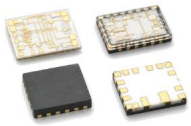
产品分类目录

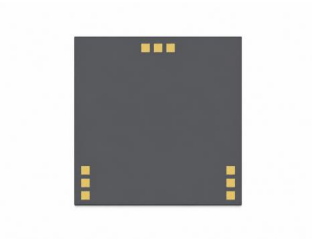
集成无源射频器件

集成无源器件将多个无源元件集成于同一基板或封装，可实现射频匹配、滤波、平衡与不平衡转换或耦合等功能。

产品: 32

版本: 11 · 修订日期: 2026-11-11





LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 2 × 2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 18000; 数值: 2000–18000; 单位: MHz

隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 3700; 最大值: 5000; 数值: 3700–5000; 单位: MHz

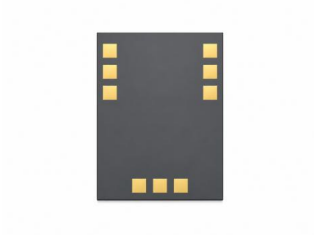
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 14 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 500; 最大值: 2700; 数值: 500–2700; 单位: MHz

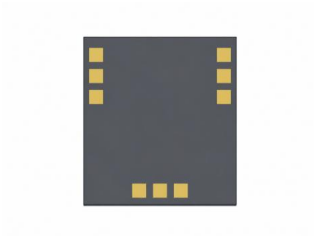
隔离度: 典型值: 14; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 18 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 800; 最大值: 2000; 数值: 800–2000; 单位: MHz

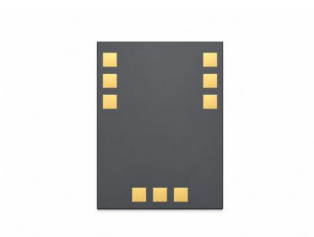
隔离度: 典型值: 18; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 18 dB (典型值); 输入驻波比: 1.4 (典型值); 输出驻波比: 1.4 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 1000; 最大值: 4000; 数值: 1000–4000; 单位: MHz

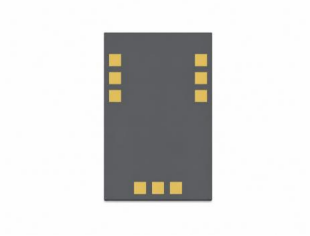
隔离度: 典型值: 18; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.4

输出驻波比: 典型值: 1.4

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

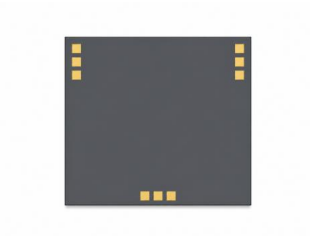
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 18000; 数值: 2000–18000; 单位: MHz

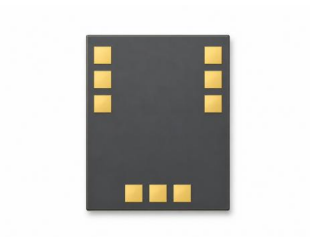
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 30 dB (典型值); 输入驻波比: 1.1 (典型值); 输出驻波比: 1.1 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

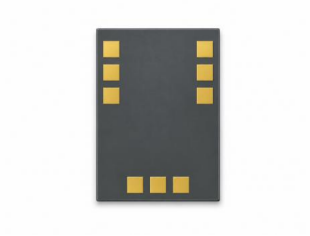
隔离度: 典型值: 30; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.1

输出驻波比: 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 25 dB (典型值); 输入驻波比: 1.1 (典型值); 输出驻波比: 1.1 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 5000; 最大值: 7000; 数值: 5000–7000; 单位: MHz

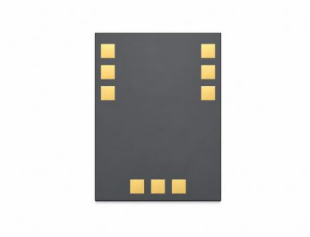
隔离度: 典型值: 25; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.1

输出驻波比: 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 25 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 5000; 最大值: 13000; 数值: 5000–13000; 单位: MHz

隔离度: 典型值: 25; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

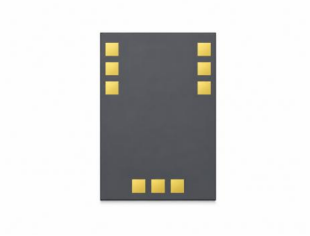
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 25 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 7000; 最大值: 13000; 数值: 7000–13000; 单位: MHz

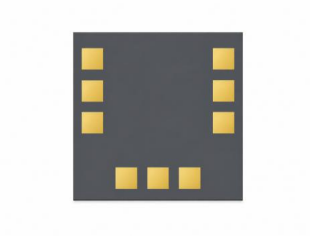
隔离度: 典型值: 25; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.1 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

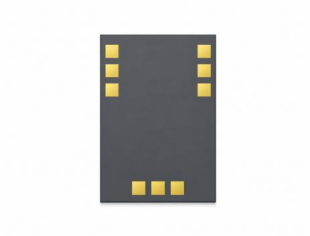
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 30 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 10000; 最大值: 20000; 数值: 10000–20000; 单位: MHz

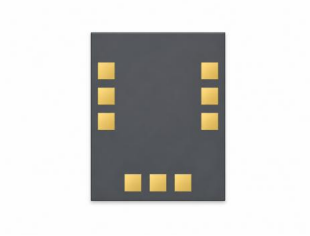
隔离度: 典型值: 30; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 25 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.1 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 12000; 最大值: 18000; 数值: 12000–18000; 单位: MHz

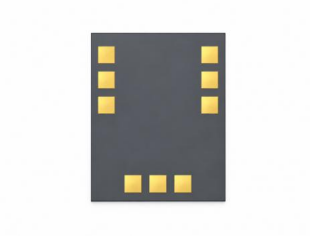
隔离度: 典型值: 25; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 30000; 最大值: 40000; 数值: 30000–40000; 单位: MHz

隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 0 dB; 输入/输出驻波比: 1.2 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 0; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.2

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 1 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 1; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 2 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 2; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 3 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 3; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz 4 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 4 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 4; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 8 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 8; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz 16 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 16 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 16; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 0 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.6 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 0; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.6; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 1 dB; 输入/输出驻波比: 1.4 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 1; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.4

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 2 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 2; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 3 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 3; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz 5 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 5 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 5; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz 6 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 6 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 6; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 8 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 8; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz 10 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 10 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

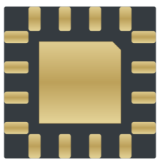
衰减量: 数值: 10; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCXOV-DC-40000-C

DC–40000 MHz 封装射频交叉跳线器 — ISO 30 dB (典型值)

DC–40000 MHz; 插入损耗 -1.4 dB (典型值); 隔离度 30 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: DC; 最大值: 40000; 数值: DC–40000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: -1.4; 单位: dB

隔离度: 典型值: 30; 单位: dB

输入/输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。